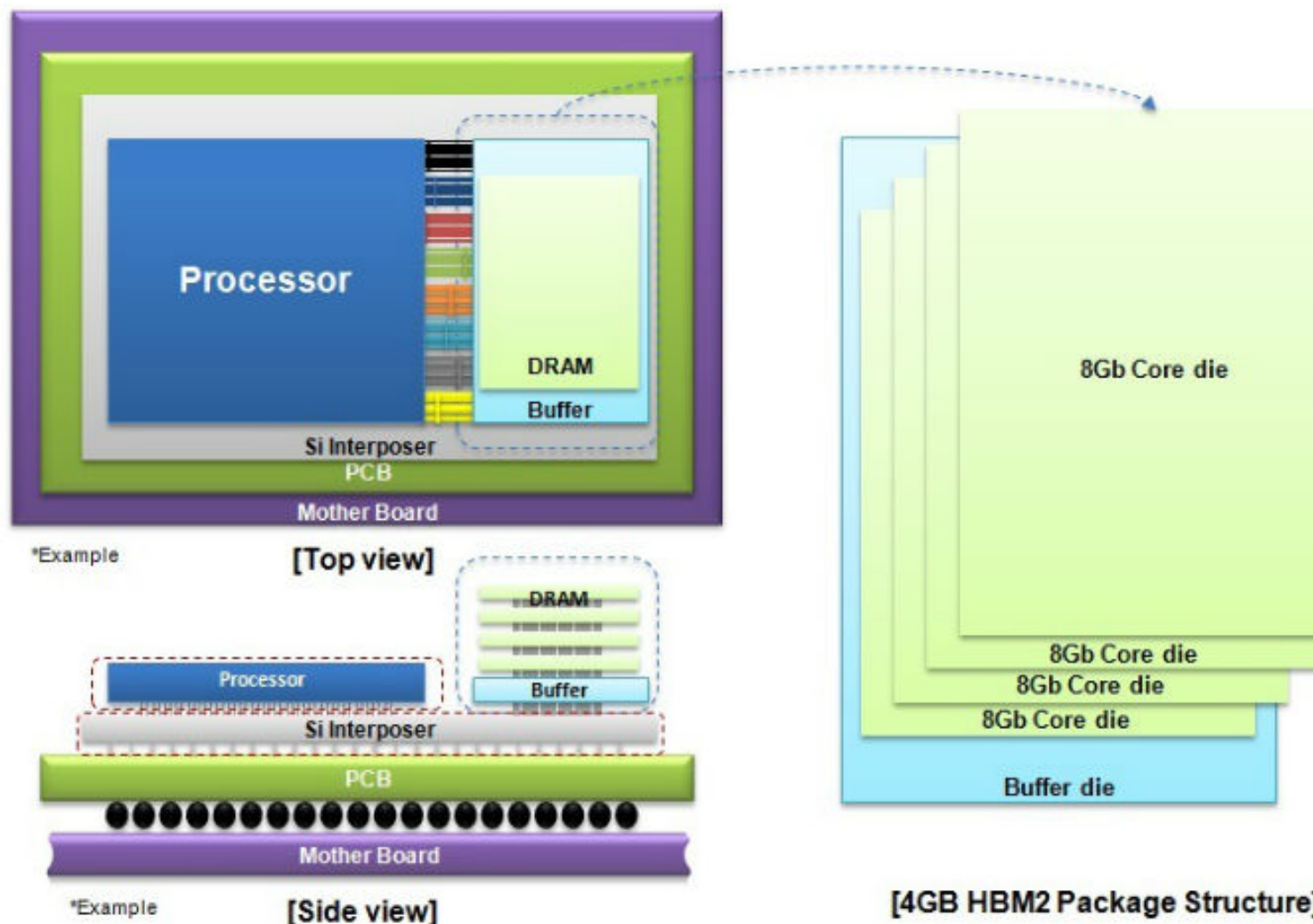


Samsung spustil výrobu momentálne najrýchlejšej 4 GB DRAM pamäte, využívajúcej druhú generáciu vysoko priepustného rozhrania HBM2 (až 256GBps). Vyrobené budú 20-nm technológiou.

HBM2 rozhranie je určené na 3D montáž - t.j. jednotlivé čipy sú na sebe (vertikálne) a sú priamo prepojené pomocou vodivých otvorov v nosnom kremíku.



src: Samsung

[Odkazy](#)

[Celá správa.](#)